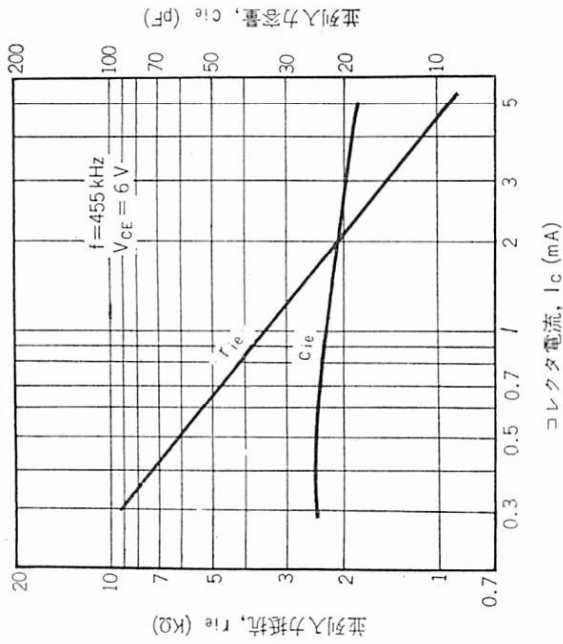
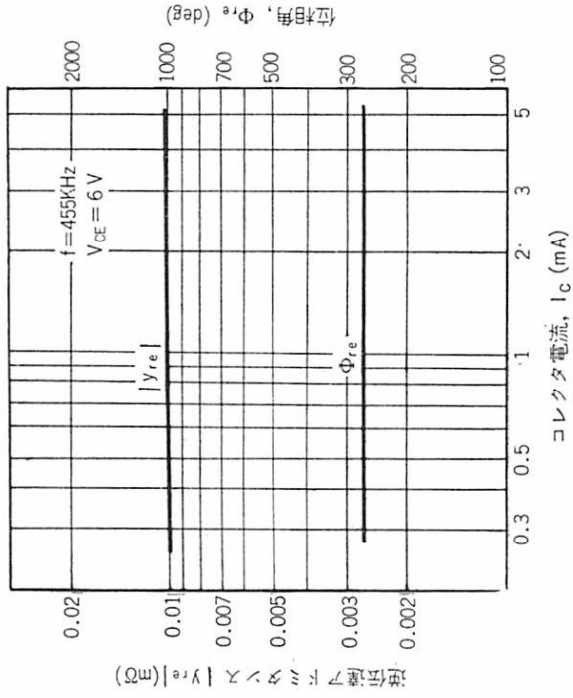


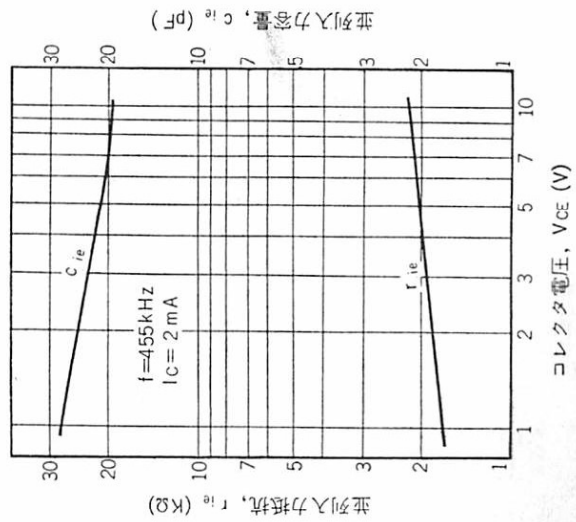
2SC536, 2SC537 y_{ie} の電流特性



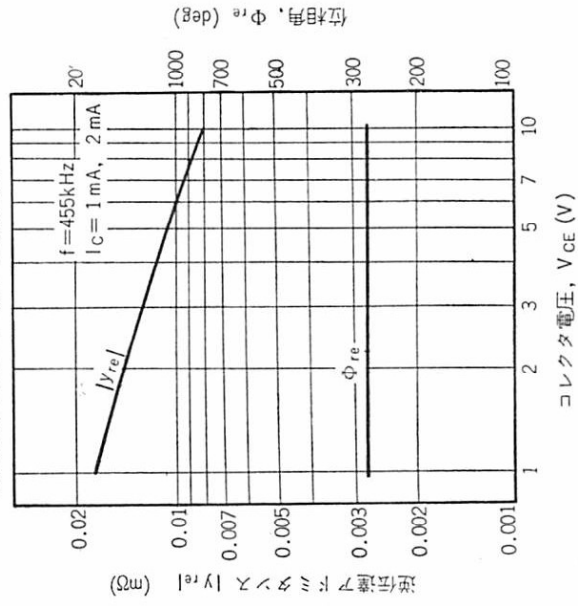
2SC536, 2SC537 y_{re} の電流特性



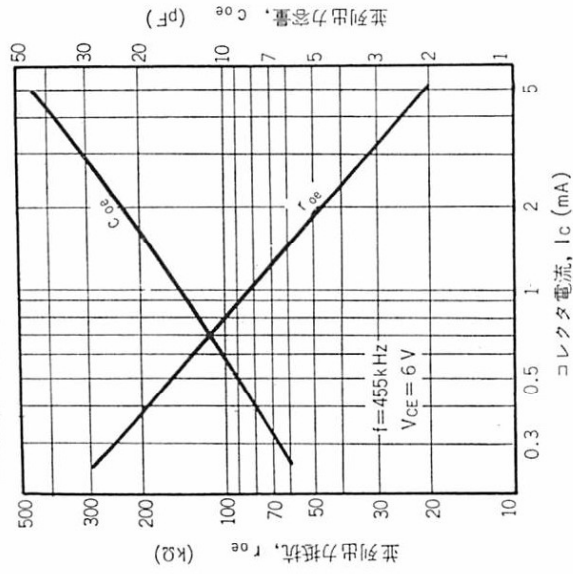
2SC536, 2SC537 y_{ie} の電圧特性



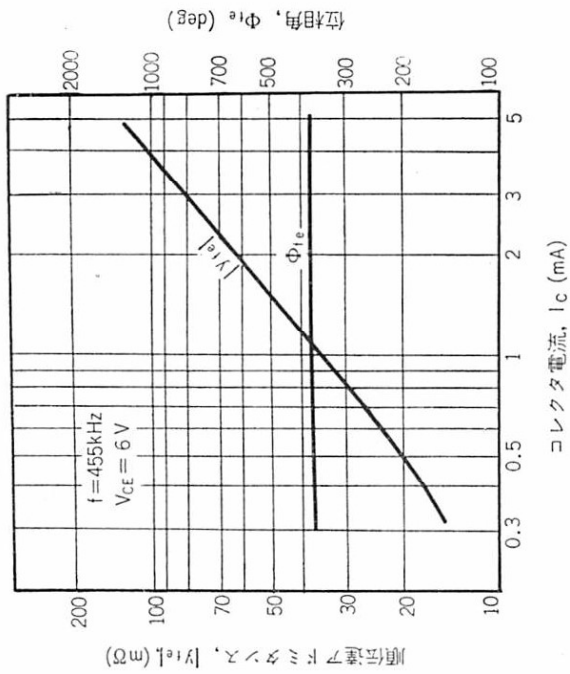
2SC536, 2SC537 y_{re} の電圧特性



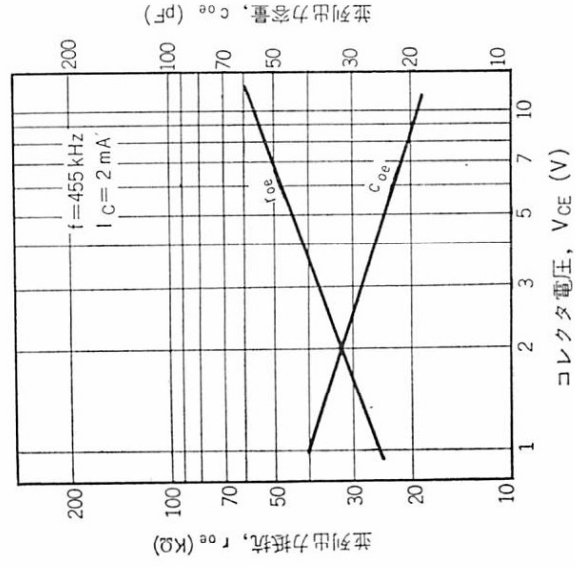
2SC536, 2SC537 y_{oe} の電流特性



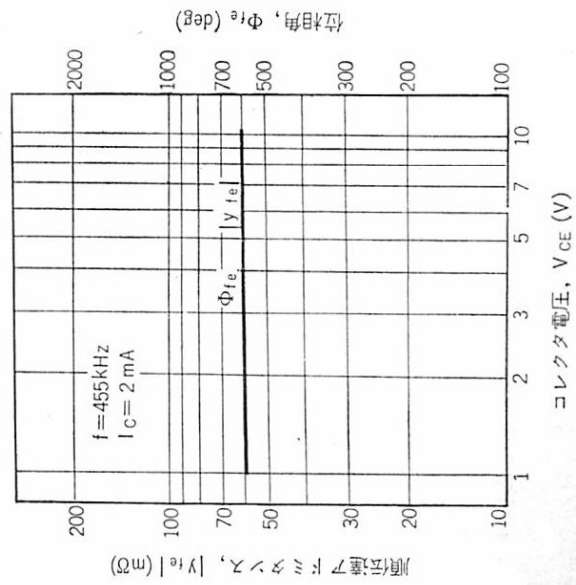
2SC536, 2SC537 y_{fe} の電流特性



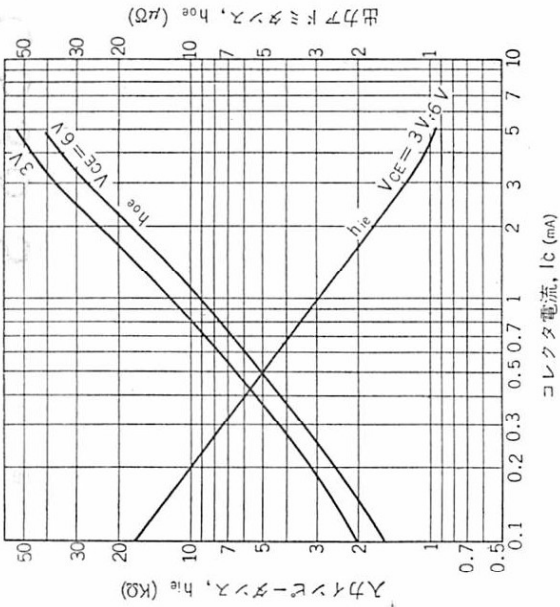
2SC536, 2SC537 y_{oe} の電圧特性



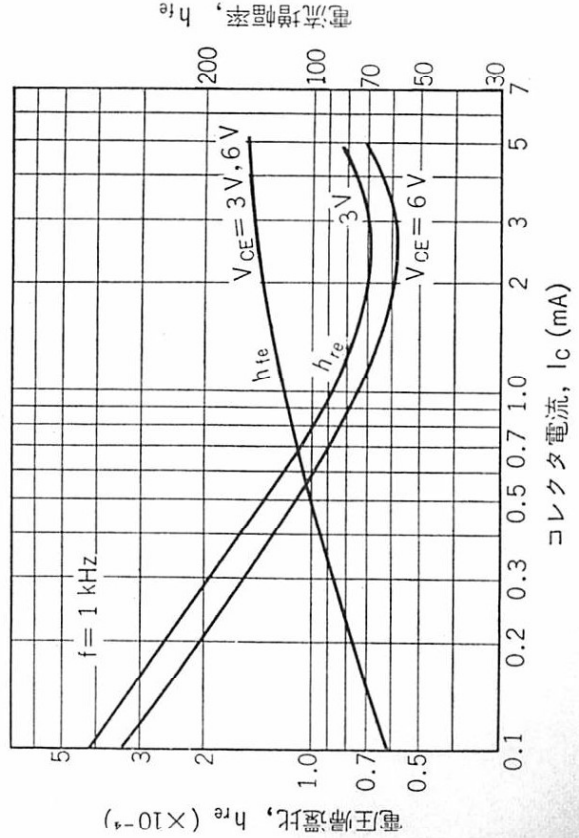
2SC536, 2SC537 y_{fe} の電圧特性



2SC536, 2SC537 h_{te} , h_{oe} の電流特性

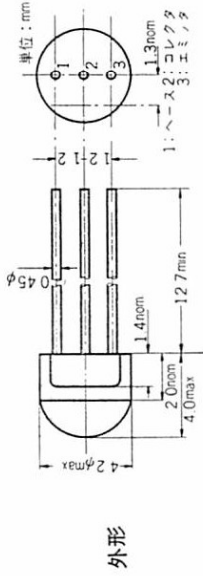


2SC536, 2SC537 h_{re} , h_{fe} の電流特性



(354)

2SC536 S シリコンNPNプレーナ形
小信号増幅用



特性については 2SC536 もご参照ください。

I. 最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	40	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	4	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	30	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	120	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$

II. 電氣的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

コレクタ遮断電流	I_{CB0}	最小	標準	最大
($V_{CB} = 35\text{V}$, $I_E = 0$)				0.1 μA
エミッタ遮断電流	I_{EB0}			0.1 μA
($V_{EB} = 3\text{V}$, $I_C = 0$)				
コレクタ・エミッタ破壊電圧	BV_{CEO}			
($I_C = 10\mu\text{A}$, $R_{BE} = \infty$)		30		
直流電流増幅率	h_{FE}			
($V_{CE} = 6\text{V}$, $I_C = 1\text{mA}$)		80		
利得帯域幅積	f_T			
($V_{CE} = 6\text{V}$, $I_C = 1\text{mA}$)		130		MHz
出力容量	C_{ob}			
($V_{CB} = 6\text{V}$, $I_E = 0$, $f = 1\text{MHz}$)		3	5	pF

(355)